SIA

Sicoresemi 仕芯半导体

性能特点

● 宽带宽: 6GHz~18GHz

● 低噪声: 1.5dB典型值

● 小信号增益: 18.8dB

● 输出P1dB: 15dBm

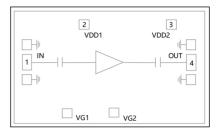
● 输出IP3: 28dBm

● 芯片尺寸: 1.4mm*1.07mm*0.1mm

典型应用

- 点对点通信
- 点对多点通信
- 仪器仪表

功能框图



概述

SIA071是一款6GHz~18GHz低噪声宽带放大器,采用GaAs工艺制造。该放大器具有自偏压功能,输入输出端50Ω匹配负载。该器件可作为混频器的本振驱动。

电性能表(T_A=+25℃)

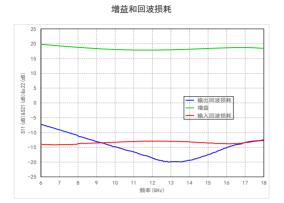
参数名称	描述	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率			6~18		GHz
增益			18. 8		dB
增益平坦度			±1		dB
输入回波损耗			<-12		dB
输出回波损耗			<-8		dB
输出功率1dB压缩点			15		dBm
饱和功率			17		dBm
输出IP3			28		dBm
噪声系数			1.5		dB
工作电流			70		mA
工作电压	VDD1、VDD2		3. 5		٧

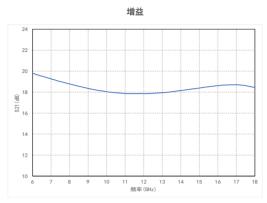
成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号中电科航空电子产业园1号楼

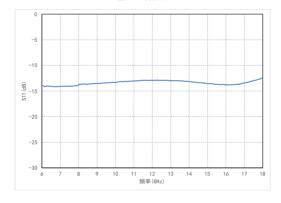


测试曲线

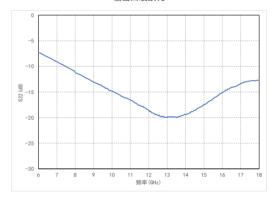




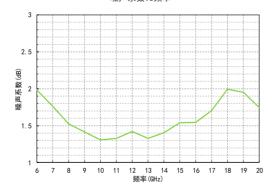
输入回波损耗



输出回波损耗



噪声系数VS频率



成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号中电科航空电子产业园1号楼

SIA



V0.2 2302

工作参数

工作温度	-55°C∼+85°C
偏置电压 VDD1,VDD2	3. 5V

绝对最大额定值

存储温度	-65°C∼+150°C	
偏置电压 VDD1, VDD2	4. 5V	
ESD-HBM	TBD	

注意事项

- 1. 禁止试图用湿化学方法清洁芯片表面。
- 2. 本品属于静电敏感器件,储存和使用时注意防静电。
- 3. 干燥、氮气环境储存。





引脚定义

键合压点定义

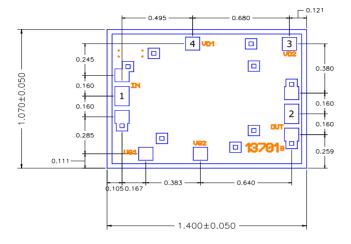
序号	功能符号	功能描述	尺寸
1	RFIN	射频输入端口,有隔直电容	100um X 150um
2	RFOUT	射频输出端口,有隔直电容	100um X 150um
3	VD2	电源端口2,外接100pF&0. 1uF电容	100um X 100um
4	VD1	电源端口1,外接100pF&0.01uF电容	100um X 100um

成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号中电科航空电子产业园1号楼

外形尺寸图

Sicoresemi 仕芯半导体



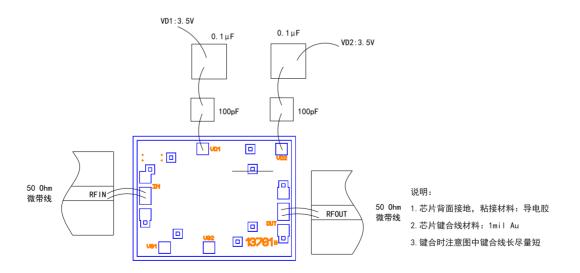
说明:

- 1. 单位: 毫米
- 2. 键合压点镀金
- 3. 芯片厚度: 0.100mm ± 0.150mm
- 4. 不能在通孔上进行键合,未编号键合压点也不需要键合。
- 5. 芯片背面镀金
- 6. 芯片背面接地

芯片装配图

放

SIA



成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax: 028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com

地址:成都市高新西区百川路9号中电科航空电子产业园1号楼